

КП801



Октава

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

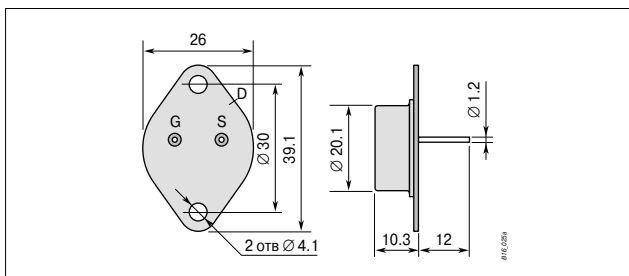
Транзисторы КП801 представляют собой первые отечественные транзисторы со статической индукцией. Разработаны в 1982—1983 гг. Предназначены для применения в выходных каскадах высококачественных усилителей мощности звуковой частоты. Конструктивно транзистор выполнен таким образом, что работать эффективно он может только в полевом режиме.

Диапазон рабочих температур: $-60...+85^{\circ}\text{C}$.

ТИПОНОМИНАЛЫ

Типономинал	Диапазон температур [С]	Крутизна [мА/В]
КП801А	—	600
КП801Б	$-60...+85$	450
КП801В	$-60...+85$	800
КП801Г	$-60...+85$	800

КОРПУС



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при $T = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, если не оговорено противное

Параметр	Условия	КП801А		КП801Б		КП801В		КП801Г		Единица измерения
		min	max	min	max	min	max	min	max	
Напряжение отсечки	$V_{DS} = 70 \text{ В}^*$, $I_D = 10 \text{ мА}$,	-30	—	-30	—	-30	—	-30	—	В
Ток утечки затвора	$V_{GS} = -15 \text{ В}$, $V_{DS} = -15 \text{ В}$	—	0.3	—	—	—	0.3	—	0.3	мА
	$V_{GS} = -25 \text{ В}$, $V_{DS} = -25 \text{ В}$	—	—	—	0.3	—	—	—	—	мА
Крутизна характеристики	$V_{DS} = 15 \text{ В}$, $I_D = 4 \text{ А}$	600	—	—	—	—	—	—	—	мА/В
	$T = 85 \pm 5^{\circ}\text{C}$, $V_{DS} = 15 \text{ В}$, $I_D = 3 \text{ А}$	—	—	450	—	—	—	—	—	
	$T = -45 \pm 3^{\circ}\text{C}$, $V_{DS} = 20 \text{ В}$, $I_D = 4 \text{ А}$	—	—	—	—	800	—	800	—	
Начальный ток стока	$V_{DS} = 5.0 \text{ В}$, $V_{GS} = 0.6 \text{ В}$	—	—	—	—	3.5	—	3.0	—	А
Обратный ток перехода затвор—сток	$V_{DS} = 110 \text{ В}$	—	0.3	—	—	—	—	—	—	мА
	$V_{DS} = 90 \text{ В}$	—	—	—	0.3	—	—	—	—	
	$V_{DS} = 150 \text{ В}$	—	—	—	—	—	0.3	—	—	
	$V_{DS} = 180 \text{ В}$	—	—	—	—	—	—	—	0.3	

*Для КП801В, КП801Г $V_{DS} = 75 \text{ В}$.

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Параметр	КП801А	КП801Б	КП801В	КП801Г	Единица измерения
Напряжение затвор—исток	-35	-35	-40	-40	В
Напряжение затвор—сток	110	90	150	180	В
Напряжение сток—исток	75	75	110	140	В
Постоянный ток стока	5	5	8	8	А
Постоянная рассеиваемая мощность*	60	60	100	100	Вт
Импульсная рассеиваемая мощность (при $\tau_p = 100 \text{ мс}$)	200	200	300	300	Вт
Температура перехода	175	175	175	175	$^{\circ}\text{C}$

*В интервале температур от $+25^{\circ}\text{C}$ до $+125^{\circ}\text{C}$ максимально допустима постоянная мощность рассеяния рассчитывается по формулам:

$P_D (\text{max}) = 60 (1 - (T_C - 25)/125)$ Вт для КП801А, КП801Б;

$P_D (\text{max}) = 100 (1 - (T_C - 25)/125)$ Вт для КП801В, КП801Г.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

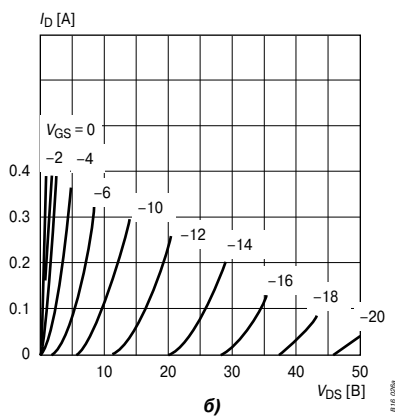
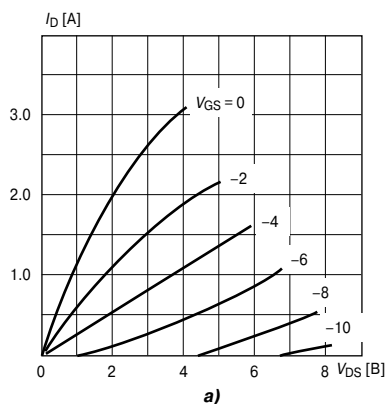


Рис. 1. Зависимость тока стока от напряжения сток—исток транзисторов КТ801А

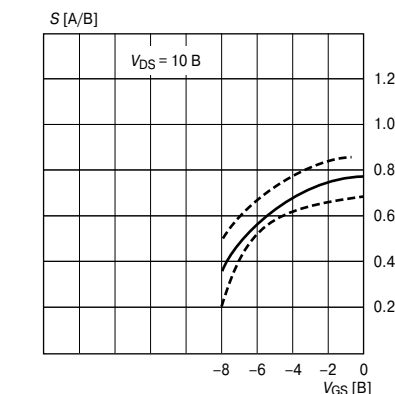


Рис. 3. Зависимость крутизны характеристики транзистора КТ801А от напряжения затвор—исток

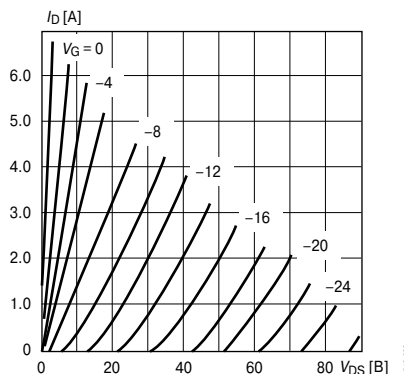


Рис. 4. Зависимость тока стока от напряжения сток—исток транзисторов КТ801В/Г

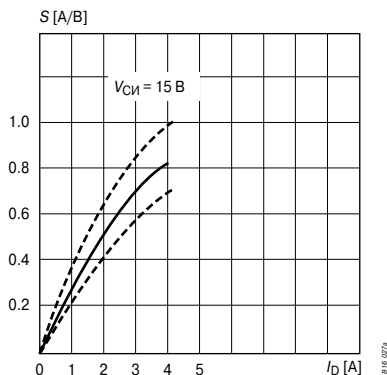


Рис. 2. Зависимость крутизны характеристики транзистора КТ801А от тока стока

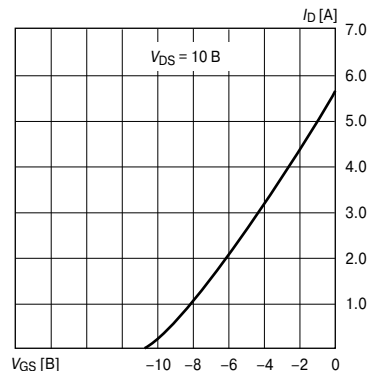
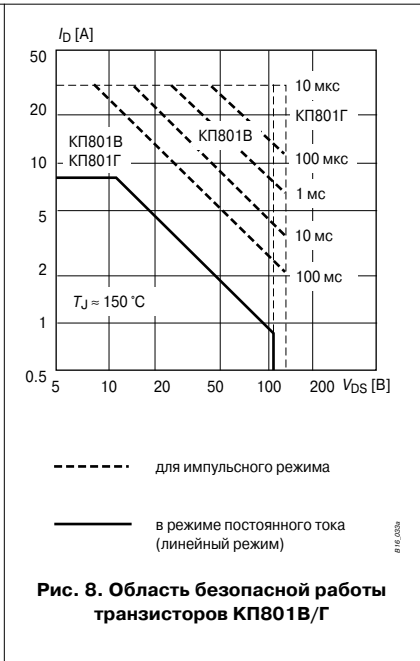
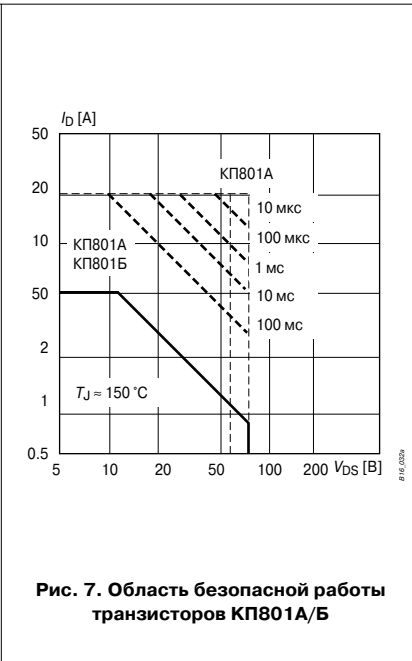
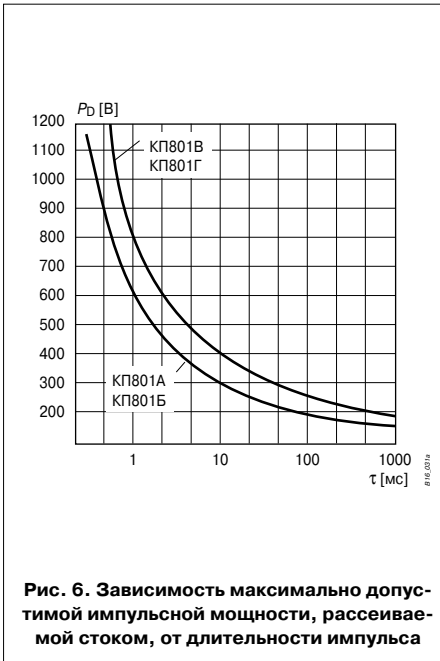


Рис. 5. Вольт-амперная характеристика транзисторов КТ801В/Г

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



2П802, КП802  **Октава**

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Кремниевые транзисторы со статической индукцией, эпитаксиально-планарные с затвором на основе *p-n*-перехода и вертикальным каналом *n*-типа, переключательные. Предназначены для применения в преобразователях постоянного напряжения, быстродействующих переключательных устройствах.

ТИПОНОМИНАЛЫ

Типономинал	Диапазон температур [°C]	Крутизна [мА/В]
2П802А	-60...+125	600
КП802А	-45...+85	450
КП802Б	-45...+85	800

КОРПУС

